

Изобретение относится к области электроники, в частности к технологии получения датчиков, и может быть использовано для получения датчиков на основе оксидных слоев полупроводников или металлов.

Способ получения датчиков, по первому варианту, включает нанесение химических компонентов оксидных слоев полупроводников или металлов в присутствии ультрафиолетовых лучей. Затем осуществляют быструю фототермическую обработку полученных материалов в вакууме или в воздухе, или в газовой камере, например с кислородом.

Способ получения датчиков, по второму варианту, включает нанесение химических компонентов оксидных слоев полупроводников или металлов в присутствии ультрафиолетовых лучей. Дополнительно, одновременно с нанесением химических компонентов осуществляют легирование полученных материалов, по меньшей мере, одной донорской или акцепторной примесью. Затем осуществляют быструю фототермическую обработку полученных материалов в вакууме или в воздухе, или в газовой камере, например с кислородом.

Способ получения датчиков, по третьему варианту, включает нанесение химических компонентов оксидных слоев полупроводников или металлов в присутствии ультрафиолетовых лучей. Дополнительно, осуществляют легирование полученных материалов, по меньшей мере, одной донорской или акцепторной примесью, и затем осуществляют фототермическую быструю обработку полученных материалов в вакууме или в воздухе, или в газовой камере, например, с кислородом.

Способ получения датчиков, по четвертому варианту, включает нанесение химических компонентов оксидных слоев полупроводников или металлов в присутствии ультрафиолетовых лучей. Затем дополнительно осуществляют фототермическую быструю обработку полученных материалов в вакууме или в воздухе, или в газовой камере, например с кислородом, и одновременно их легирование, по меньшей мере, одной донорской или акцепторной примесью.

Способ получения датчиков, по пятому варианту, включает нанесение химических компонентов оксидных слоев полупроводников или металлов в присутствии ультрафиолетовых лучей. Дополнительно осуществляют легирование полученных материалов, по меньшей мере, одной примесью донорской или акцепторной, при этом концентрация примесей, введенных при легировании, составляет максимально возможную для полученного материала, и затем фототермическую быструю обработку полученных материалов, которую осуществляют в условиях понижения температуры от температуры легирования до температуры окружающей среды в вакууме или в воздухе, или в газовой камере, например с кислородом.

П. формулы: 5

Фиг.: 4